



硅晶体管对管系列产品

FH3/4K 型硅 PNP/NPN 高频小功率开关晶体管对管

1、特性

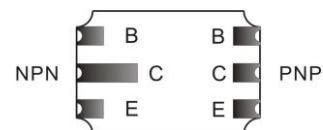
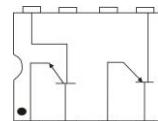
芯片采用硅外延平面结构，器件采用 D08S2 和 LCC-6 型金属陶瓷封装。

器件具有特征频率高、开关时间小、体积小、重量轻，可靠性高的特点。

器件的静电放电敏感度为 4000V。



D08S2 型



LCC-6 型

注：LCC-6 封装产品型号后缀加“U”标识。

2、质量等级及执行标准

G、G+：Q/RBJ9212（D08S2 型），Q/RBJ1026QZ（LCC-6 型），QZJ840611；

JP、JT、JCT（D08S2 型）：Q/RBJ21034-2007, GJB33A-1997。

3、最大额定值

器件额定值见表 1，除另有规定外， $T_A=25^\circ\text{C}$ 。

表 1 最大额定值

型 号	$P_{\text{tot}}^{\text{a}}$ mW	V_{CBO} V	V_{CEO} V	V_{EBO} V	I_{CM} A	T_{stg}, T_j $^\circ\text{C}$
FH3/4K	700×2	50	45	4	0.2	-55~150

^a P_{tot} 为 700mW 是指 $T_A=25^\circ\text{C}$ 时一个芯片工作另一个芯片不工作时的功率；
两个芯片都工作时，每个芯片功率为 350mW。

4、主要电特性

主要电特性（除另有规定外， $T_A=25^\circ\text{C}$ ）见表 2。

表 2 主要电特性

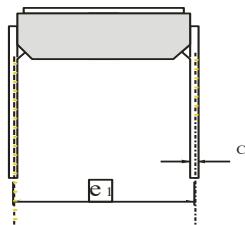
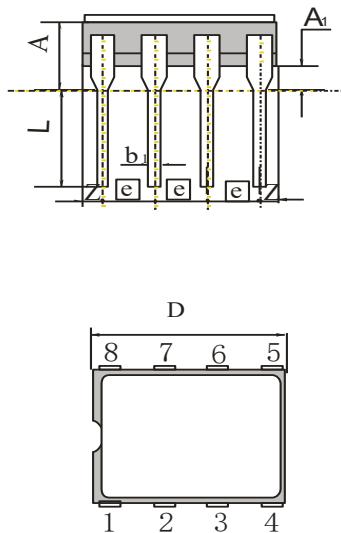
参 数		数 值			单 位
符 号	测 试 条 件	最 小 值	典 型 值	最 大 值	
$V_{(\text{BR})\text{CBO}}$	$I_C=0.1\text{mA}$	50	—	—	V
$V_{(\text{BR})\text{CEO}}$	$I_C=0.1\text{mA}$	45	—	—	V
$V_{(\text{BR})\text{EBO}}$	$I_E=0.1\text{mA}$	4	—	—	V
I_{CBO}	$V_{\text{CB}}=10\text{V}$	—	0.05	0.1	μA
I_{CEO}	$V_{\text{CE}}=10\text{V}$	—	0.05	0.1	μA
I_{EBO}	$V_{\text{EB}}=2\text{V}$	—	0.05	0.1	μA
h_{FE}	$V_{\text{CE}}=15\text{V}, I_C=60\text{mA}$	40	—	150	—
两管 $ h_{\text{FE}}/h_{\text{FE}(\text{最大})} ^{\text{a}}$	$V_{\text{CE}}=15\text{V}, I_C=60\text{mA}$	—	—	10%	—
$V_{\text{BE}(\text{sat})}$	$I_C=100\text{mA}, I_B=10\text{mA}$	—	0.8	1.0	V
$V_{\text{CE}(\text{sat})}$	$I_C=100\text{mA}, I_B=10\text{mA}$	—	0.1	0.5	V
f_T	$V_{\text{CE}}=10\text{V}, I_C=50\text{mA}, f=30\text{MHz}$	120	150	—	MHz

注：本表中参数为每个单管的电特性。



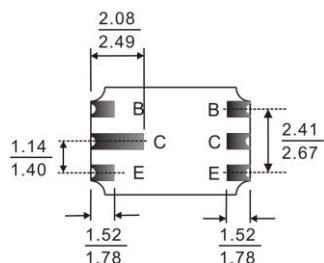
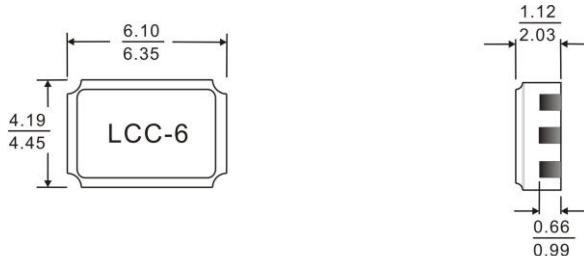
硅晶体管对管系列产品

5、外形尺寸



尺寸符号	数值		
	最小	典型值	最大
A	—	—	5.10
A ₁	0.51	—	—
b ₁	0.4	—	0.6
c	0.2	—	0.4
D	9.0	—	11.0
e	—	2.54	—
e ₁	—	7.62	—
L	3.50	—	5.00
Z	—	—	1.27

D08S2 外形尺寸



LCC-6 外形尺寸

6、使用和维护

6.1 器件的安装

安装质量的好坏对器件的可靠性影响很大，在安装、测试等过程中轻拿轻放，避免碰撞、重物碾压，从而影响其密封性。

安装焊接时，器件允许耐焊接热的条件是温度 260℃下不超过 10 秒；浸锡温度不超过 260℃，时间不超过 10 秒。

6.2 器件的使用

测试或筛选时应严格按规定条件、方法进行，应使用合格的设备、仪器仪表，并对其进行校验；操作人员必须持证上岗，必要时要进行专门培训。

严禁超规范使用，注意防潮、防尘，严禁裸手直接接触器件。

测试设备、仪器仪表可靠接地。

测试过程中应采取静电防护措施。